

小型半导体/固体激光器---皮秒激光器

皮秒激光器

特点：

- 脉宽<80 ps，峰值功率高达3 W
- 波长375 nm-1650 nm
- 重频从单脉冲-100 MHz

应用：

荧光寿命测试、光子探测器、光电时间响应表征、紧凑紫蓝色激光器、光时域反射 (OTDR)、激光种子源、时域分辨荧光、荧光寿命成像 (FLIM)、磷光寿命成像 (PLIM)、荧光相关光谱学 (FCS)、光学层析、荧光寿命相关光谱 (FLCS)、受激发射损耗显微镜 (STED)、双焦荧光相关光谱学 (2fFCS)、脉冲交错激励 (PIE)、荧光各项异性、单线态氧、激光切割/消融、时间分辨光致发光成像等。



技术参数

Wavelength (+/-5 nm)	Product Description and Specifications				
	Pulse width ps	Peak power mW	25MHz average power mW	50MHz average power mW	Beam divergence mrad
375 nm	<80 ps	300 mW	0.25	0.50	1.0
405 nm	<80 ps	1200 mW	1.00	2.00	1.0
445 nm	<80 ps	400 mW	0.40	0.80	1.0
462 nm	<80 ps	1000 mW	0.85	1.60	3.0
473 nm	<80 ps	400 mW	0.35	0.70	1.0
488 nm	<80 ps	500 mW	0.45	0.80	1.1
515 nm	<80 ps	400 mW	0.35	0.70	1.1
532 nm	<80 ps	150 mW	0.15	0.30	1.1
561 nm	<80 ps	150 mW	0.15	0.30	1.1
593 nm	<80 ps	100 mW	0.10	0.20	1.1
633 nm	<80 ps	300 mW	0.25	0.50	1.2
660 nm	<80 ps	400 mW	0.35	0.70	1.2
685 nm	<80 ps	300 mW	0.25	0.50	1.2
725 nm	<80 ps	300 mW	0.25	0.50	1.2
785 nm	<80 ps	800 mW	0.70	1.40	1.2
808 nm	<80 ps	900 mW	0.75	1.50	1.2
830 nm	<80 ps	900 mW	0.75	1.50	1.3
860 nm	<80 ps	900 mW	0.75	1.50	1.3
910 nm	<80 ps	300 mW	0.25	0.50	1.3
947 nm	<80 ps	400 mW	0.30	0.60	1.3
980 nm	<80 ps	400 mW	0.30	0.60	1.4
1030 nm	<80 ps	500 mW	0.45	0.90	1.4
1064 nm	<80 ps	500 mW	0.45	0.90	1.4
1080 nm	<80 ps	500 mW	0.45	0.90	1.5
1320 nm	<80 ps	900 mW	0.75	1.50	1.5
1550 nm	<80 ps	900 mW	0.75	1.50	1.5
Dimensions of laser head	12 x 3 x 3.6 cm (L,W,H)				
Dimensions of power supply	AC: 5x14x15 cm (2x5x6 inch) DC: 3.5x8.5x12.7 cm				
Warm-up time	<1 min				
Operation temperature	10 to 35 degree C				
Operation voltage	90-250 VAC 12 VDC input available				
Power consumption	10 W, typical				